

## Micron: memoria NAND TCL 3D per smartphone con AI, VR e Face ID

- Ultima modifica: Martedì, 13 Marzo 2018 09:59

Publicato: Martedì, 13 Marzo 2018 09:42

Scritto da Redazione



Micron Technology ha annunciato tre nuove memorie NAND 3D a 64 strati di seconda generazione, che supportano lo standard ad alta velocità di Memorizzazione Flash Universale (UFS) 2.1. Disponibili in capacità da 256GB, 128GB e 64GB.

Le nuove **memorie NAND 3D di Micron** sono destinate ad applicazioni mobili e quindi a tutti i produttori di smartphone, che vorranno migliorare l'esperienza dell'utente con funzioni di nuova

## Micron: memoria NAND TLC 3D per smartphone con AI, VR e Face ID

- Ultima modifica: Martedì, 13 Marzo 2018 09:59

Pubblicato: Martedì, 13 Marzo 2018 09:42

Scritto da Redazione

generazione come ad esempio l'intelligenza artificiale (AI), la realtà virtuale e il riconoscimento facciale. L'emergere dell'AI (intelligenza artificiale) nei telefoni di punta spinge l'esigenza di avere soluzioni di memoria più avanzate, che consentano un accesso ai dati più rapido ed efficiente.

Inoltre la capacità di archiviazione continua ad aumentare in modo significativo da quando gli smartphone sono diventati dispositivi per la fotografia e la condivisione multimediale, con un **massimo di 256 GB** nei telefoni di punta oggi, destinati a crescere a un terabyte entro il 2021. Le nuove soluzioni di memoria NAND 64L 3D TLC di Micron affrontano tali esigenze utilizzando un'architettura mobile ottimizzata per fornire **prestazioni elevate e bassa latenza**, e offrendo più capacità in meno spazio.

## Micron: memoria NAND TCL 3D per smartphone con AI, VR e Face ID

- Ultima modifica: Martedì, 13 Marzo 2018 09:59

Pubblicato: Martedì, 13 Marzo 2018 09:42

Scritto da Redazione



I nuovi prodotti NAND 3D mobili impacchettano più celle di memoria in un'area più piccola del dispositivo e utilizzando la **tecnologia CMOS Array (CuA)** di Micron offrono la migliore dimensione disponibile del componente. L'approccio unico di Micron pone tutti gli strati di memoria flash al di sopra della matrice logica, massimizzando l'utilizzo dello spazio nella progettazione dello smartphone.

La NAND 3D TLC di 2a generazione per applicazioni mobili offre diversi vantaggi tecnici competitivi, tra cui le nuove funzionalità descritte di seguito:

## Micron: memoria NAND TLC 3D per smartphone con AI, VR e Face ID

- Ultima modifica: Martedì, 13 Marzo 2018 09:59

Pubblicato: Martedì, 13 Marzo 2018 09:42

Scritto da Redazione

- L'architettura mobile ottimizzata di Micron fornisce **prestazioni elevate e bassa latenza** per una migliore esperienza utente, riducendo al minimo il consumo di energia con servizi come la modalità sleep efficiente.
- I nuovi prodotti NAND 3D 64L TLC di Micron sono del **50% più veloci** rispetto alla generazione precedente NAND TLC 3D.
- “La tecnologia NAND 3D 64L di Micron **raddoppia la densità di memoria** della precedente generazione NAND TLC 3D mantenendo la stessa dimensione del package”.
- La specifica di interfaccia 2.1 G3-2L UFS offre prestazioni convincenti per le applicazioni mobili, fornendo una **larghezza di banda fino al 200 per cento più elevata** rispetto allo standard eMMC 5.1 e fornendo capacità di lettura e scrittura simultanee. Questa caratteristica è alla base della rapidità di accesso ai dati necessaria per scattare foto ad alta risoluzione o registrare video 4K nella memoria.
- I nuovi prodotti sono basati su uno dispositivo da 32 GB che misura appena 59.341 mm<sup>2</sup>, che offre **il più piccolo ingombro fisico del settore**.